

Rys. 1-834. SC206

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy

Firma: RFT

Wykonanie: tranzystor krzemowy planarny *n-p-n* w obudowie plastikowej, ciężar około 0,1 G

Zastosowanie: układy wejściowe i wzбудzające m.cz. powszechnego zastosowania

Typy podobne: BSX68 (Val), 2N4264 (Mot), SCX06 (RFT), BC167 (Siem)

Wartości charakterystyczne¹⁾

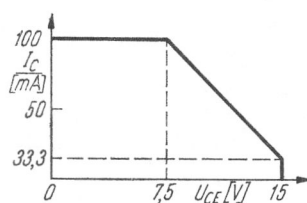
	min	typ	max		
I_{CBO}		1	100	nA	przy $U_{CB} = 20$ V
I_{EBO}		0,001	1	μ A	przy $U_{EB} = 5$ V
$U_{(BR)CEO}$	15			V	przy $I_C = 10$ mA
$U_{(BR)EBO}$	5	8		V	przy $I_E = 10$ μ A
h_{21E} (B)	28		71		przy $U_{CE} = 6$ V, $I_C = 2$ mA, $f = 1$ kHz
(C)	56		140		
(D)	112		280		
(E)	224		560		
(F)	450		1120		
f_T	300			MHz	przy $U_{CE} = 6$ V, $I_C = 10$ mA, $f = 100$ MHz
F		16	25	dB	przy $U_{CE} = 6$ V, $I_C = 200$ μ A, $R_G = 500$ Ω , $\Delta f = 850$ Hz, $f = 1$ kHz
h_{11e}	1,4	2,3		k Ω	przy $U_{CE} = 6$ V, $I_C = 2$ mA, $f = 1$ kHz
h_{12e}		3,8	9,5	10^{-4}	
h_{21e}	29				
h_{22e}		48	80	μ S	

Wartości graniczne

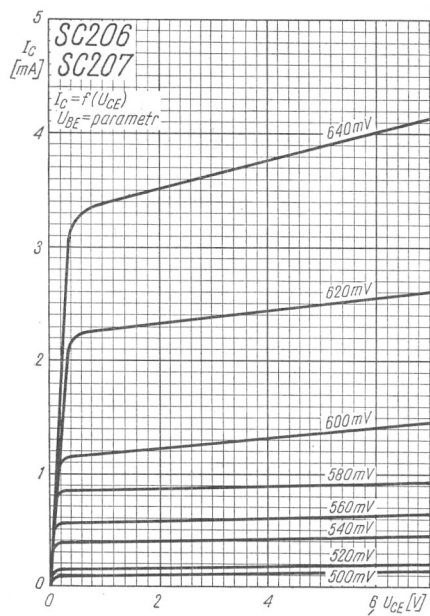
U_{CBO} max	20	V	P_{tot} max	200 ²⁾	mW
U_{CEO} max	15	V	t_j max	125	$^{\circ}$ C
U_{EBO} max	5	V	t_{amb}	-40 ÷ +100	$^{\circ}$ C
I_C max	100	mA	R_{thj-a}	$\leq 0,5$	$^{\circ}$ C/mW
I_B max	10	mA			

¹⁾ $t_{amb} = 25^{\circ}$ C (-5° C)

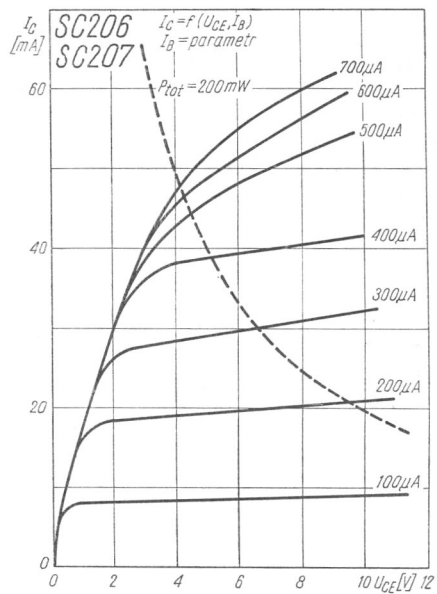
²⁾ $t_{amb} = 25^{\circ}$ C



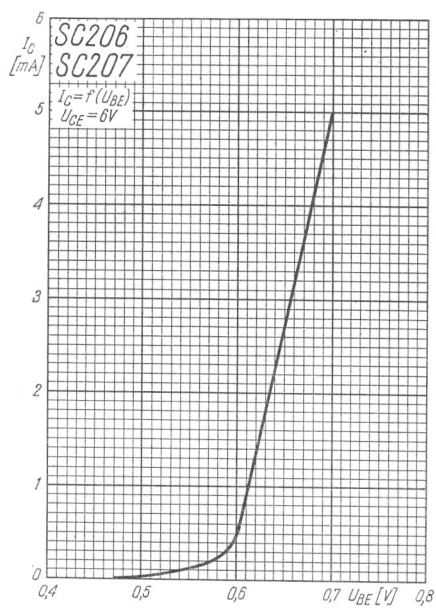
Rys. 1-835. Dopuszczalny zakres pracy



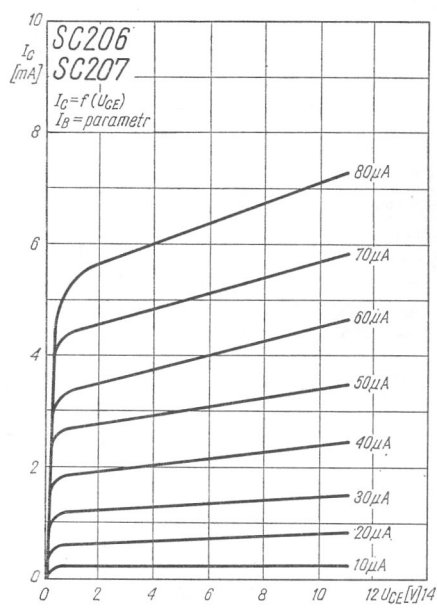
Rys. 1-836. Charakterystyki wyjściowe



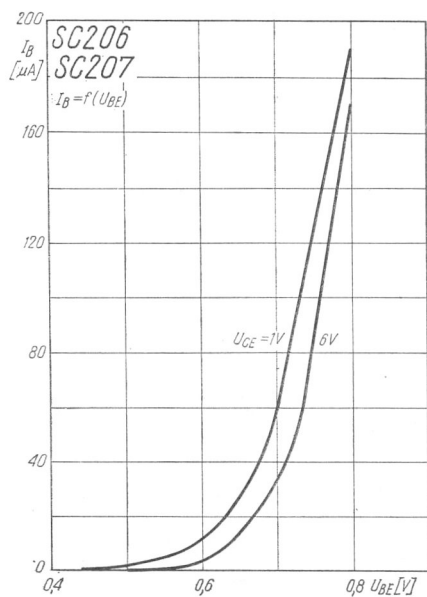
Rys. 1-837. Charakterystyki wyjściowe



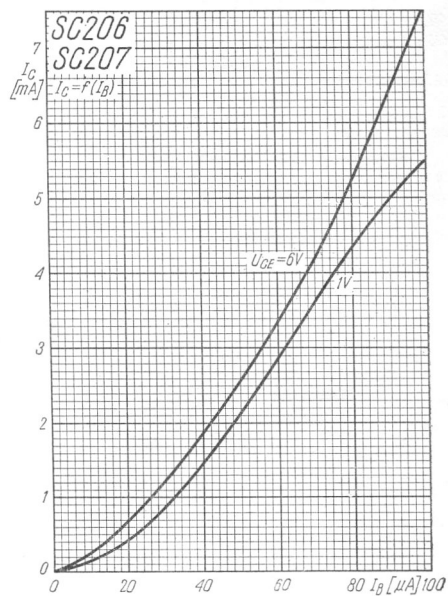
Rys. 1-838. Charakterystyka sterowania napięciowego



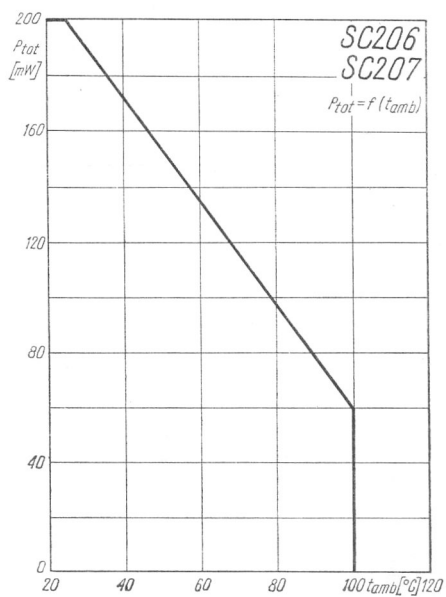
Rys. 1-839. Charakterystyki wyjściowe



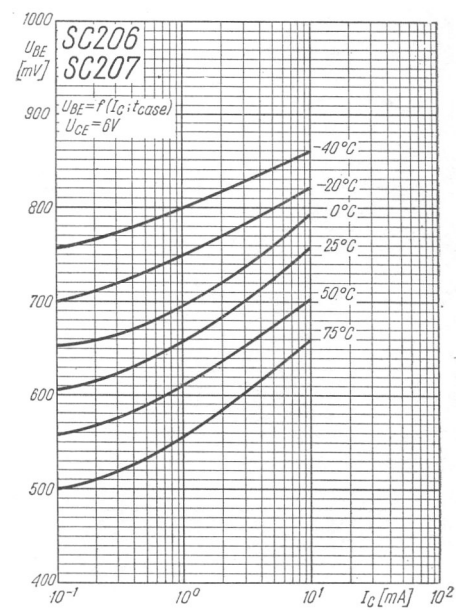
Rys. 1-840. Charakterystyki wejściowe



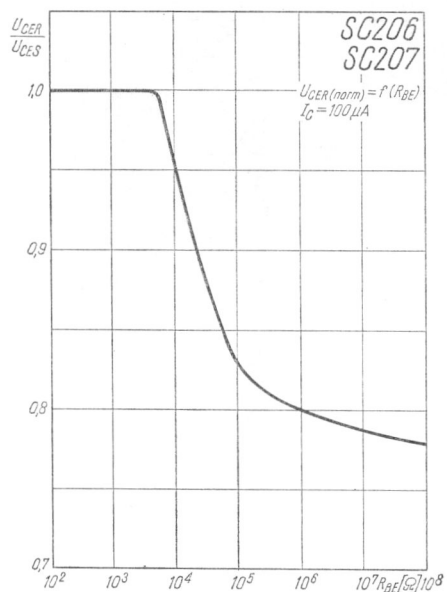
Rys. 1-841. Charakterystyki sterowania prądowego



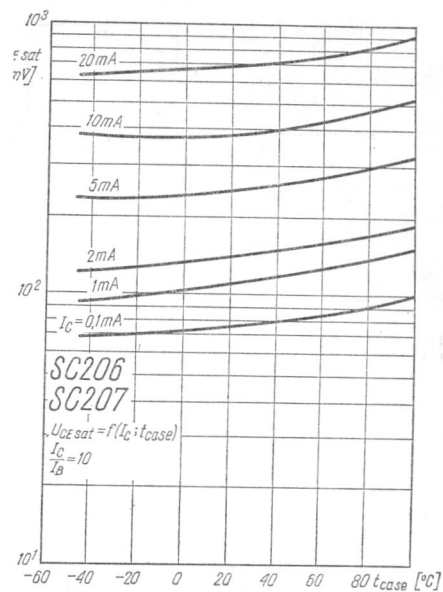
Rys. 1-842. Zależność dopuszczalnej mocy strat od temperatury otoczenia



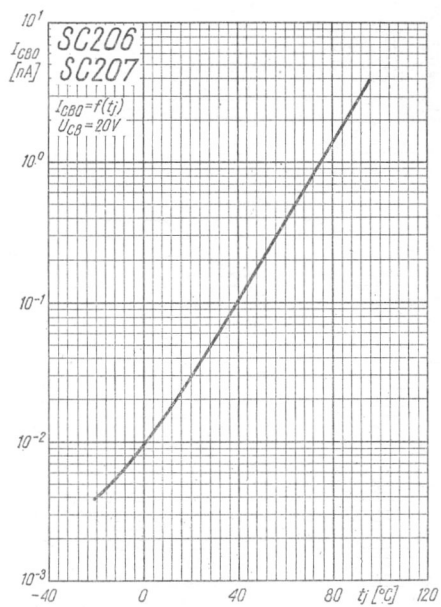
Rys. 1-843. Zależność napięcia U_{BE} od prądu kolektora



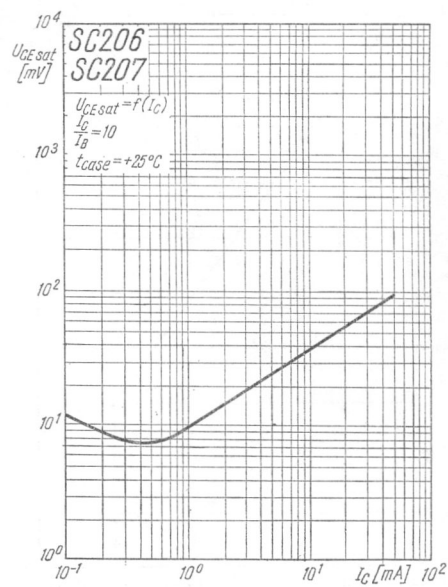
Rys. 1-844. Zależność napięcia kolektora od rezystancji R_{BE}



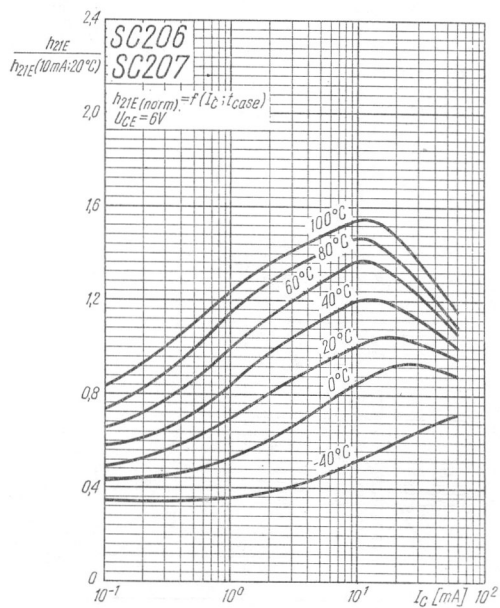
Rys. 1-845. Zależność napięcia nasycenia kolektora od temperatury obudowy



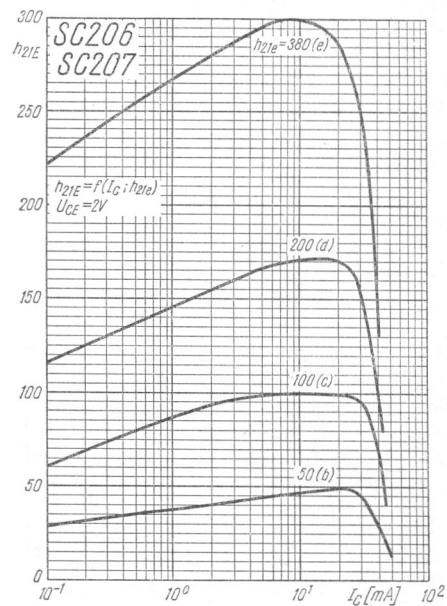
Rys. 1-846. Zależność prądu zerowego kolektora od temperatury złącza



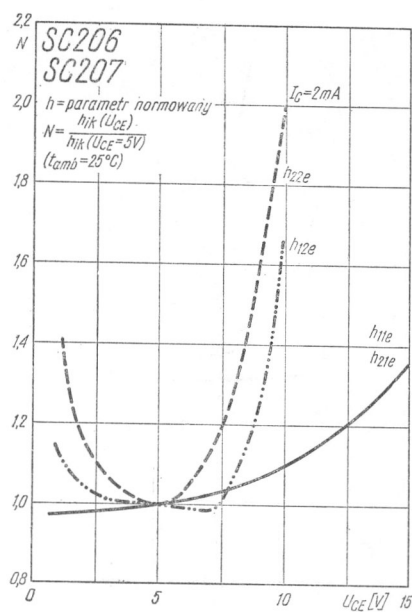
Rys. 1-847. Zależność napięcia nasycenia kolektora od prądu kolektora



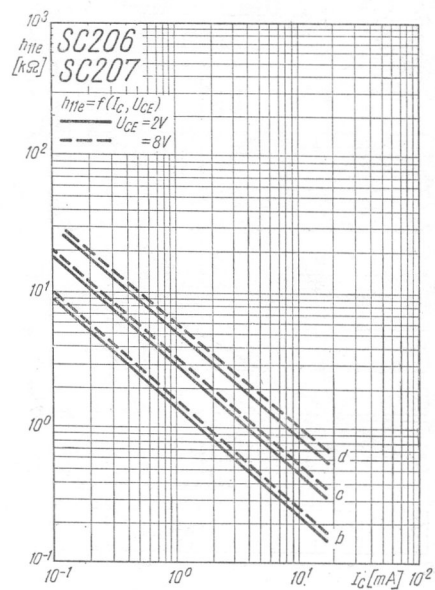
Rys. 1-848. Zależność współczynnika wzmocnienia prądowego od prądu kolektora



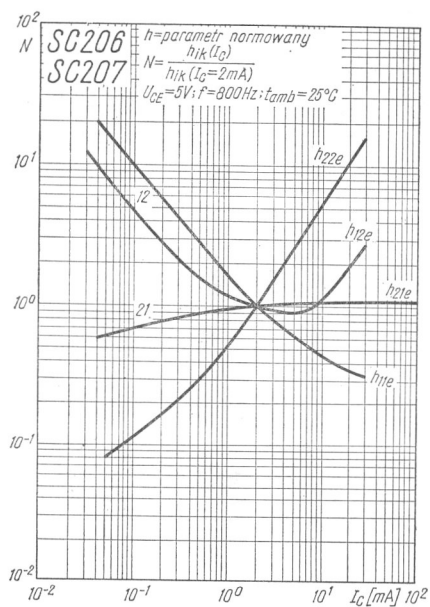
Rys. 1-849. Zależność współczynnika wzmocnienia prądowego od prądu kolektora



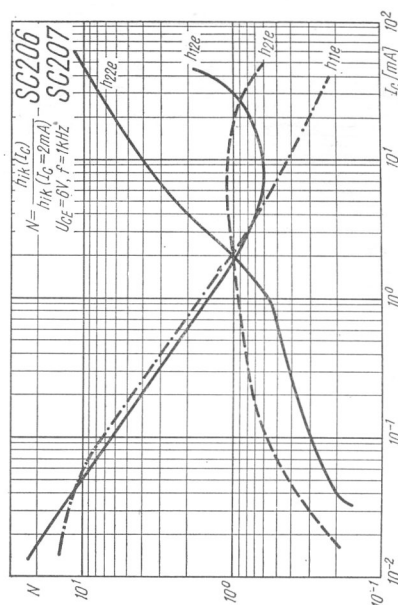
Rys. 1-850. Zależność napięciowa parametrów h



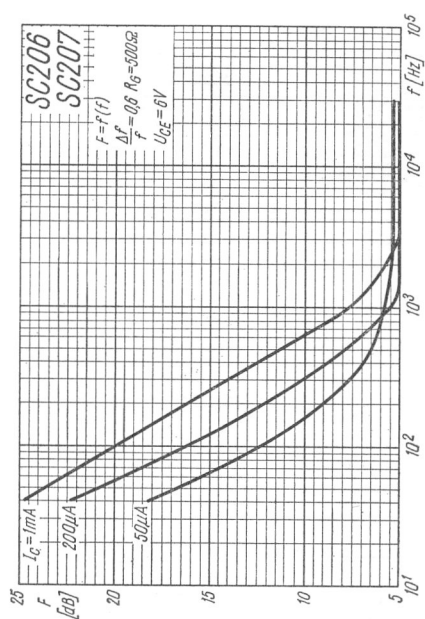
Rys. 1-851. Zależność impedancji wejściowej od prądu kolektora



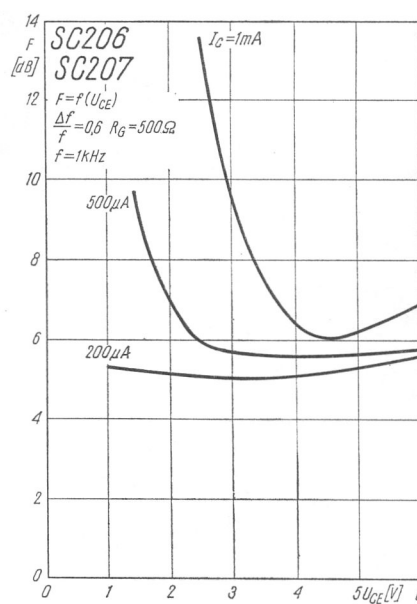
Rys. 1-852. Zależność parametrów h od prądu kolektora



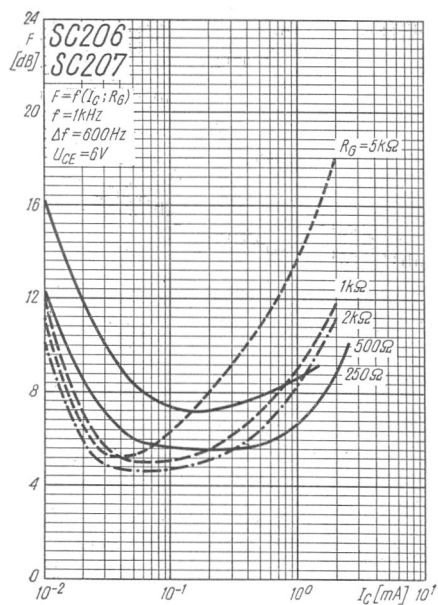
Rys. 1-853. Zależność parametrów h od prądu kolektora



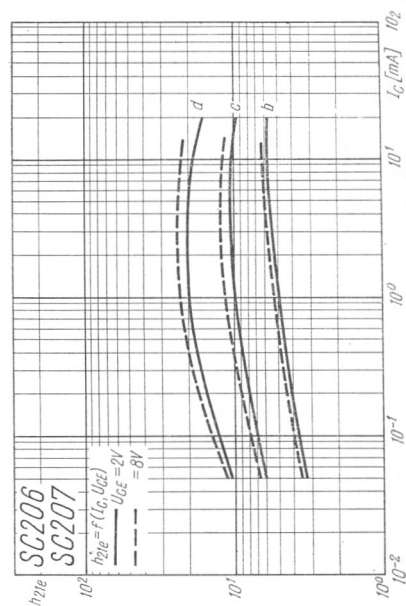
Rys. 1-854. Zależność współczynnika szumów od częstotliwości



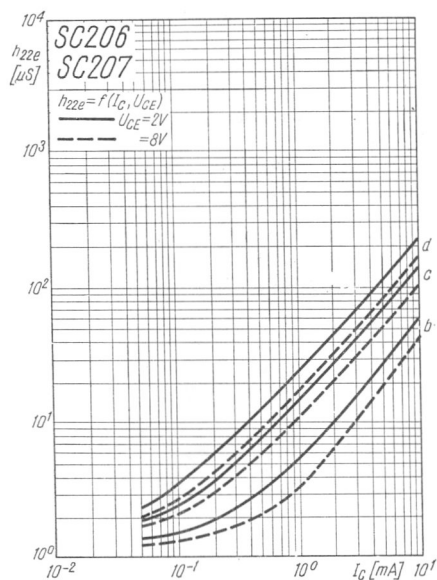
Rys. 1-855. Zależność współczynnika szumów od napięcia kolektora



Rys. 1-856. Zależność współczynnika szumów od prądu kolektora



Rys. 1-857. Zależność współczynnika wzmocnienia prądowego h_{21e} od prądu kolektora



Rys. 1-858. Zależność admittancji wyjściowej od prądu kolektora